

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ

заведующего кафедрой общей физики и физики конденсированного состояния
физического факультета МГУ, профессора

ХОХЛОВА Дмитрия Ремовича

1. А.А.Жуков, В.Н.Никифоров, Д.Р.Хохлов, С.М.Чудинов. Магнитное вымораживание в сплавах Bi-Sb в области прямого и инверсного спектра. *Материалы XX Всесоюзного совещания по физике низких температур, Москва, 1979*, ч. I, с. 110-111.
2. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, С.М.Чудинов, О.Б.Яценко. Аномальное поведение примесных центров в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{Ga})$ под действием давления. *Письма в ЖЭТФ*, **31** 304-307 (1980).
3. Д.Р.Хохлов. Новые явления в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$. *Материалы XVIII Всесоюзной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»*, Новосибирск, 1980, сер. «Физика», с. 18-24.
4. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Границы фоточувствительности сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, легированных In , Al , Ga , Cd . *Материалы V Всесоюзного симпозиума по полупроводникам с узкой запрещенной зоной и полуметаллам*, Львов, 1980, ч. I, с. 176-178.
5. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Фотопроводимость сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, легированных Al , Ga , In , Cd . *Препринт № 1/1980 физического факультета МГУ*, Москва, 1980, с. 1-9.
6. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Фотопроводимость сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, легированных Al , Ga , In , Cd . *Письма в ЖТФ*, **6** 1269-1273 (1980).
7. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, А.А.Жуков, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Особенности зонной структуры сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ с высокой концентрацией индия. *ФТП*, **15** 2232-2234 (1981).
8. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Кинетика фотопроводимости сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, легированных In . *Препринт № 13/1981 физического факультета МГУ*, Москва, 1981, с. 1-9.
9. В.А.Акимов, Н.В.Брандт, С.О.Климонский, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Dynamics of the semiconductor-metal transition induced by infrared illumination in $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ alloys. *Phys. Lett. A*, **88A** 483-486 (1982).
10. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, В.В.Соковишин, Д.Р.Хохлов. Неравновесное металлическое состояние в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$, индуцированное ИК-подсветкой и квантующим магнитным полем. *Тезисы докладов XXII Всесоюзного совещания по физике низких температур*, Кишинев, 1982, ч. II, с. 148-149.
11. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, А.М.Гаськов, В.П.Зломанов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Примесные состояния Ga и фотоэлектрические явления в сплавах $\text{PbTe}(\text{Ga})$. *ФТП*, **17** 87-92 (1983).
12. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, К.Р.Курбанов, Л.И.Рябова, А.Т.Хасанов, Д.Р.Хохлов. Фотоэлектрические явления в PbTe , легированном индием. *ФТП*, **17** 1604-1608 (1983).
13. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Возможность деформационных корреляций локализованных состояний в $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. *Тезисы докладов XXIII Всесоюзного совещания по физике низких температур*, Таллин, 1984, ч. II, с. 168-169.

14. Б.А.Акимов, А.В.Албул, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Фотоэлектрические явления в сплавах $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ с различным содержанием индия. *ФТП*, **18** 1778-1783 (1984).
15. Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Механизмы гашения остаточной фотопроводимости в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Тезисы докладов совещания по физике узкозонных полупроводников*, Москва, 1985, с. 29.
16. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, К.Н.Егоров, Р.В.Луцив, С.Н.Чесноков, Д.Р.Хохлов. Объемно-неравновесные состояния в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *ФТП*, **21** 1379-1381 (1987).
17. Б.А.Акимов, А.М.Гаськов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Перестройка энергетического спектра в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(Cd)$ под действием давления. *ФТП*, **21** 1588-1593 (1987).
18. Б.А.Акимов, А.В.Сазонов, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Диффузия фотовозбужденных носителей заряда в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Материалы Всесоюзного семинара «Примеси и дефекты в узкозонных полупроводниках»*, Павлодар, 1987, с. 161-164.
19. Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Особенности спектров поглощения и фотопроводимости сплавов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Тезисы докладов III школы по актуальным вопросам физики полуметаллов и узкозонных полупроводников*. Тирасполь, 1987, с. 37.
20. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. СВЧ-гашение остаточной фотопроводимости в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Письма в ЖТФ*, **14** 731-735 (1988).
21. В.А.Акимов, N.B.Brandt, S.N.Chesnokov, K.N.Egorov, D.R.Khokhlov. Local unequilibrium states in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ ($x=0.25$). *Solid State Commun.*, **66** 811-813 (1988).
22. Б.А.Акимов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Электронные метастабильные состояния в теллуридах свинца и олова. Новые принципы фотоприема. *Тезисы докладов II Дальневосточной школы по физике и химии твердого тела*, Благовещенск, 1988, с. 52-54.
23. Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Гигантское отрицательное магнитосопротивление в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Тезисы докладов Всесоюзной конференции по физике полупроводников*, Кишинев, 1988, т. III, с. 76-77.
24. Б.А.Акимов, А.В.Никорич, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Проводимость сплавов $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$ при комбинированном воздействии электрического и магнитного полей. *ФТП*, **23** 668-672 (1989).
25. Б.А.Акимов, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Динамика движения рабочей точки на падающей ветви вольтамперной характеристики сплавов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *ФТП*, **23** 899-900 (1989).
26. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Физические принципы построения ИК-систем на основе явления задержанной фотопроводимости. *Труды координационного совещания социалистических стран по физическим проблемам оптоэлектроники*, Баку, 1989, с. 157.
27. И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Отрицательное магнитосопротивление и стимуляция фотопроводимости магнитным полем в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Труды координационного совещания социалистических стран по физическим проблемам оптоэлектроники*, Баку, 1989, с.190.
28. В.А.Акимов, N.B.Brandt, D.R.Khokhlov, L.I.Ryabova. Local metastable states in A^4B^6 . *International Conference on Narrow-Gap Semiconductors and related Materials*, Gaithersburg, Maryland, USA, June, 1989, Abstracts, E6.
29. S.N.Chesnokov, D.R.Khokhlov. UHF-quenching of the persistent photoconductivity in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *International Conference on Narrow-Gap Semiconductors and related Materials*, Gaithersburg, Maryland, USA, June, 1989, Abstracts, F6.

30. S.N.Chesnokov, D.R.Khokhlov. Giant negative magnetoresistance in the $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ alloys. *International Conference on Narrow-Gap Semiconductors and related Materials*, Gaithersburg, Maryland, USA, June, 1989, Abstracts, F6.
31. I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, A.V.Nikorich, Z.Popovich, N.Romchevich. On the nature of the persistent photoconductivity effect in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *VIII International Conference on Ternary and Multinary Compounds*, Kishinev, USSR, September 1990, Abstracts, p. 318.
32. К.Н.Егоров, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Статические вольтамперные характеристики сплавов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в магнитном поле и при воздействии ИК-подсветки. В сборнике «Структура и свойства соединений A^4B^6 » под ред. А.Н.Ковалева, Москва, «Металлургия», 1990, с. 113-120.
33. А.И.Белогорохов, Д.Р.Хохлов. Новые возможности регистрации ИК-излучения с помощью фоточувствительных материалов на основе $PbTe(Ga)$. Тезисы докладов научно-технической конференции «Перспективные материалы твердотельной электроники», Минск, 1990, с. 63-64.
34. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov, A.V.Nikorich, W.Konig. Far-infrared study of In doped $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ single crystals. *Infrared Phys.*, **31** 225-230 (1991).
35. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov, A.V.Nikorich, W.Konig. Far-infrared study of localized states in In-doped $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ single crystals. *Phys.Rev.B*, **43** 6712-6716 (1991).
36. Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. СВЧ-стимуляция задержанной фотопроводимости в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Материаловедение халькогенидных полупроводников», Черновцы, октябрь 1991, ч. I, с. 96.
37. А.И.Белогорохов, Л.И.Белогорохова, Д.Р.Хохлов. Проявление коллективных эффектов, вызванных электронной подсистемой, в оптических и фотостимулированных спектрах в $PbTe(Ga)$. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Материаловедение халькогенидных полупроводников», Черновцы, октябрь 1991, ч. II, с.54.
38. А.И.Белогорохов, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Проявление особенностей в спектрах отражения $PbTe(Ga)$, связанных с резонансными переходами между одно- и двухэлектронными уровнями. *Материалы VIII Всесоюзного симпозиума «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы»*, Львов, 1991, ч. II, с. 55-57.
39. И.И.Иванчик, А.В.Никорич, З.Попович, Н.Ромчевич, Д.Р.Хохлов. Спектры отражения $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в далекой инфракрасной области спектра: примесные эффекты. *Материалы VIII Всесоюзного симпозиума «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы»*, Львов, 1991, ч. II, с. 107-109.
40. Б.А.Акимов, В.П.Зломанов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Перспективные материалы ИК-оптоэлектроники на основе соединений группы A^4B^6 . *Высокочистые Вещества*, **6** 22-35 (1991).
41. А.И.Белогорохов, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Photoconductivity spectra of the new infrared selective photodetector. *VIII International Conference on Fourier Transform Spectroscopy*, Lubeck-Travemunde, Germany, September 1991, Abstracts, p. 333.
42. D.R.Khokhlov, A. de Visser, A.V.Nikorich. (De)localization of nonequilibrium electrons in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ in high magnetic fields. *III International Conference on Research in High Magnetic Fields*, Amsterdam, August 1991, Abstracts, p. 82.
43. А.И.Белогорохов, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Photoconductivity spectra of the new infrared selective photodetector. *Proc. SPIE*, **1575** 3476-3477 (1991).

44. B.A.Akimov, N.B.Brandt, S.N.Chesnokov, D.R.Khokhlov. New class of semiconductor materials for infrared photodetection. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **216** 147-153 (1991).
45. A.I.Belogorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, Z.V.Popovic, N.Romcevic. Peculiarities of the far-infrared reflection spectra of the doped lead-tin tellurides revealing the persistent photoconductivity effect. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **216** 403-407 (1991).
46. Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, А.В.Никорич, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. СВЧ-резонанс задержанной фотопроводимости в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Письма в ЖЭТФ*, **55** 125-128 (1992).
47. С.А.Белоконь, Л.Н.Верещагина, И.И.Иванчик, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Характер изменения свойств $PbTe(Ga)$ при изменении степени легирования. *ФТП*, **26** 264-269 (1992).
48. А.И.Белогорохов, И.И.Иванчик, Е.И.Слынько, Д.Р.Хохлов. Спектры фотопроводимости $PbTe(Ga)$ в дальней ИК-области. *Тезисы докладов Инациональной конференции «Дефекты в полупроводниках»*, Санкт-Петербург, апрель 1992, с. 100.
49. А. Де Виссер, И.И.Иванчик, А.В.Никорич, Д.Р.Хохлов. Локализация в сверхсильных магнитных полях в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Тезисы докладов Инациональной конференции «Дефекты в полупроводниках»*, Санкт-Петербург, апрель 1992, с. 101.
50. Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. СВЧ-резонанс задержанной фотопроводимости в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Тезисы докладов Инациональной конференции «Дефекты в полупроводниках»*, Санкт-Петербург, апрель 1992, с. 102.
51. B.A.Akimov, N.B.Brandt, D.R.Khokhlov. New class of the semiconductor materials for infrared photodetection. *I Russian - Chinese Symposium «Actual Problems of Modern Materials Science»*, June 1992, Tomsk, Abstracts, p. 25-26.
52. D.R.Khokhlov, A. de Visser, I.I.Ivanchik, A.V.Nikorich. (De)localization of nonequilibrium electrons in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ in high magnetic field. *Physica B*, **177** 491-494 (1992).
53. I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, A. de Visser, A.V.Nikorich. Electron localization in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ in high magnetic field. *Solid State Commun.* **82** 759-762 (1992).
54. А. де Виссер, И.И.Иванчик, А.В.Никорич, Д.Р.Хохлов. Локализация и делокализация в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$, индуцированные сверхсильным магнитным полем и ИК-подсветкой. *ФТП*, **26** 1034-1040 (1992).
55. Д.Р.Хохлов, С.Н.Чесноков. Релаксация задержанной фотопроводимости в электрическом поле в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *ФТП*, **26** 1135-1138 (1992).
56. А.И.Белогорохов, С.А.Белоконь, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Особенности спектров ИК-отражения в $PbTe(Ga)$. *ФТТ*, **34** 2966-2968 (1992).
57. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov. Low-temperature far-infrared study of localized states in In-doped $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ single crystals. *J. Phys.: Condens. Matt.* **4** 4323-4330 (1992).
58. А.И.Белогорохов, Е.И.Слынько, Д.Р.Хохлов. Аномалии спектров фотопроводимости $PbTe(Ga)$. *Письма в ЖТФ*, **18** 30-34 (1992).
59. B.A.Akimov, D.R.Khokhlov. Lead telluride-based photodetectors: a new approach. *International Conference on Narrow-Gap Semiconductors*, Southampton, UK, July 1992, Abstracts, p. 132.
60. D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, A. de Visser, A.V.Nikorich. Magnetic field-induced localization in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *International Conference on Narrow-Gap Semiconductors*, Southampton, UK, July 1992, Abstracts, p. 133.

61. B.A.Akimov, D.R.Khokhlov. New class of the infrared photodetectors. *XXI International Conference on the Physics of Semiconductors*, Beijing, China, August 1992, Abstracts, p. 110.
62. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. Peculiarities of the infrared reflection spectra of PbTe(Ga). *XXI International Conference on the Physics of Semiconductors*, Beijing, China, August 1992, Abstracts, p. 367.
63. S.N.Chesnokov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. UHF-resonance of the persistent photoconductivity in $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. *XXI International Conference on the Physics of Semiconductors*, Beijing, China, August 1992, Abstracts, p. 381.
64. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. Peculiarities of the infrared reflection spectra of PbTe(Ga). *Proc. 21 Int. Conf. Phys. Semicond., Beijing, China, August 10-14, 1992, ed. Ping-Jiang, Hou-Zhi Zheng, World Sci. (Singapore)*, **1** 189-192 (1992).
65. B.A.Akimov, D.R.Khokhlov. New class of the infrared photodetectors. *Proc. 21 Int. Conf. Phys. Semicond., Beijing, China, August 10-14, 1992, ed. Ping-Jiang, Hou-Zhi Zheng, World Sci. (Singapore)*, **1** 1751-1754 (1992).
66. S.N.Chesnokov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. UHF-resonance of the persistent photoconductivity in $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. *Proc. 21 Int. Conf. Phys. Semicond., Beijing, China, August 10-14, 1992, ed. Ping-Jiang, Hou-Zhi Zheng, World Sci. (Singapore)*, **1** 277-280 (1992).
67. B.A.Akimov, D.R.Khokhlov. Lead telluride-based photodetectors: a new approach. *Semicond. Sci. Technol.*, **8** S349-S351 (1993).
68. D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, A. de Visser, A.V.Nikorich. Magnetic field-induced localization in $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. *Semicond. Sci. Technol.*, **8** S352-S355 (1993).
69. B.A.Akimov, D.R.Khokhlov. High-performance lead telluride-based photodetectors. *1993 Materials Research Society Spring Meeting*, San-Francisco, USA, April 1993, Abstracts, p. 80.
70. B.A.Akimov, A.V.Dmitriev, D.R.Khokhlov, L.I.Ryabova. Carrier transport and non-equilibrium phenomena in doped PbTe and related materials. *Phys. Stat. Sol. (a)*, **137** 9-55 (1993).
71. Б.А.АКИМОВ, А.В.АЛБУЛ, И.И.ИВАНЧИК, Л.И.РЯБОВА, Е.И.СЛЫНЬКО, Д.Р.ХОХЛОВ. Влияние легирования галлием на свойства твердых растворов $\text{Pb}_{1-x}\text{Ge}_x\text{Te}$. *ФТТ*, **27** 351-354 (1993).
72. L.N.Vereshagina, A.N.Zherikhin, V.N.Bagratashvili, A.P.Sviridov, S.S.Alimpiev, S.N.Nikiforov, V.N.Shevchenko, V.V.Mlinsky, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, A.M.Gaskov. Ultraviolet - laser deposition of doped PbTe thin films. *Proc. SPIE*, **1856** 46-56 (1993).
73. S.N.Chesnokov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. Microwave resonance of the persistent photoconductivity in $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ alloys. *Defect and Diffusion Forum*, **103-105** 449-452 (1993).
74. I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, A. de Visser, A.V.Nikorich. Localization in ultrahigh magnetic fields in the $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ alloys. *Defect and Diffusion Forum*, **103-105** 443-448 (1993).
75. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, E.I.Slynko. PbTe(Ga) photoconductivity spectra in the far infrared. *Defect and Diffusion Forum*, **103-105** 433-435 (1993).
76. Г.В.БЕЛОКОПЫТОВ, В.С.ПЕТРОВ, Д.Р.ХОХЛОВ. Диэлектрический СВЧ-отклик сегнетоэлектрика-полупроводника $\text{Pb}_{0.95}\text{Mn}_{0.05}\text{Te}(\text{Ga})$. *Известия РАН, сер. «Физическая»*, **57** 138-141 (1993).
77. S.N.Chesnokov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. Far infrared high-performance lead telluride-based photodetectors for space-born applications. *Infrared Phys.*, **35** 23-31 (1994).
78. B.A.Akimov, N.B.Brandt, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. A new type of material with high photosensitivity for optoelectronics and infrared technology. *J. Advanced Mater.*, **1** 13-18 (1994).

79. S.N.Chesnokov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov. Far-infrared photodetectors based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *XXII International Conference on the Physics of Semiconductors*, Vancouver, Canada, August 1994, Abstracts, Fr2-A6.
80. S.Chesnokov, D.Dolzhenko, I.Ivanchik, D.Khokhlov. Far infrared photodetectors based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Proc. 22 Int. Conf. Phys. Semicond., Vancouver, Canada, August 15-19, 1994*, ed. David J. Lockwood, *World Sci.*, **3** 2641-2644 (1994).
81. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Д.Р.Хохлов, Л.И.Рябова. Новый класс высокофоточувствительных материалов для оптоэлектроники и ИК-техники. *Научное издание программы «Университеты России» (направление II: университеты как центры фундаментальных исследований. Физика. Изд-во Московского университета, 1994, с. 79-87.*
82. В.А.Акимов, D.R.Khokhlov. High performance lead telluride-based photodetectors. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **299** 329-334 (1994).
83. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Д.Р.Хохлов, Л.И.Рябова. Новый класс высокофоточувствительных материалов для оптоэлектроники и ИК-техники. *Перспективные материалы*, **1** 9-13 (1995).
84. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, S.Ponomarev. Local lattice mode - induced far-infrared selective photoconductivity in $PbTe(Ga)$. *VII Brazilian Workshop on Semiconductor Physics*, Rio de Janeiro, Brasil, July 1995, Abstracts, TH-53.
85. D.R.Khokhlov. DX-like centers in IV-VI. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **378** 947-952 (1995).
86. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov. Raman scattering spectra of indium-doped $PbTe$. *J. Phys.: Condens. Matt.*, **7** 5105-5109 (1995).
87. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, S.V.Ponomarev. Peculiarities of the photoconductivity spectra of $PbTe(Ga)$. *International School-Conference «Physical Problems of Material Science of Semiconductors»*, Chernivtsi, Ukraine, September 1995, Abstracts, p. 165.
88. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, S.V.Ponomarev. Local lattice mode - induced far-infrared selective photoconductivity in $PbTe(Ga)$. *Brazilian Journ. Phys.*, **26** 308-312 (1996).
89. А.И.Белогорохов, И.И.Иванчик, С.В.Пономарев, Е.И.Слынько, Д.Р.Хохлов. Селективная фотопроводимость в $PbTe(Ga)$, индуцированная локальной фононной модой. *Письма в ЖЭТФ*, **63** 342-346 (1996).
90. А. де Виссер, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Особенности магнитосопротивления сплавов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ и $Pb_{1-x}Mn_xTe(In)$ в сверхсильных магнитных полях. *ФТП*, **30** 1400-1411 (1996).
91. D.R.Khokhlov, В.А.Volkov. Mixed valence, electrical activity and metastable states in doped IV-VI compounds: experiment and theory. *XXIII International Conference on the Physics of Semiconductors*, Berlin, Germany, July 1996, Abstracts, Tu3B-1.
92. D.R.Khokhlov, В.А.Volkov. Mixed valence, electrical activity and metastable states in doped IV-VI compounds: experiment and theory. *Proc. 23 Int. Conf. Phys. Semicond., Berlin, Germany, July 21-26, 1996*, ed. M.Scheffer, R.Zimmermann, *World Sci.*, **4** 2941-2948 (1996).
93. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov, W.Konig. Far infrared spectroscopy of localized states in indium doped $PbTe$ and $Pb_{1-x}A_xTe$ ($A_x = Mn_{0.017}, Sn_{0.18}$) alloys. *Infrared Phys. Technol.*, **38** 117-122 (1997).
94. I.Ivanchik, D.Khokhlov, S.Ponomarev, E.Slynko, A.Terekhov, A. de Visser, Yu.Vygranenko. Fermi level pinning effect in $PbTe(Yb)$. *II International School-conference on the Physics Problems of Materials Science of Semiconductors*, Chernivtsi, Ukraine, September 1997, Abstracts, p. 13.

95. И.И.Иванчик, С.В.Пономарев, Е.П.Скипетров, А.Терехов, Д.Р.Хохлов, Н.А.Чернова, Е.И.Слынько, Ю.К.Выграненко, А. де Виссер. Эффект стабилизации уровня Ферми и переход диэлектрик - металл под действием давления в сплавах $Pb_{1-x}Ge_xTe$, легированных иттербием. *III Всероссийская конференция по физике полупроводников*, Москва, декабрь 1997, тезисы докладов, с. 92.
96. Б.А.Акимов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. DX - подобные центры в узкозонных полупроводниках A^4B^6 . *III Всероссийская конференция по физике полупроводников*, Москва, декабрь 1997, тезисы докладов, с. 374.
97. D.Khokhlov. New type of infrared photodetectors based on lead telluride and related alloys. *1997 Materials Research Society Fall Meeting*, Boston, USA, December 1997, Abstracts, p. 170-171.
98. A.Belgorokhov, I.Ivanchik, D.Khokhlov. PbTe(Ga) - new multispectral infrared photodetector. *1997 Materials Research Society Fall Meeting*, Boston, USA, December 1997, Abstracts, p. 171.
99. A.I.Belgorokhov, L.I.Belgorokhova, D.R.Khokhlov. Nonmonotonous behaviour of temperature dependence of plasma frequency and effect of a local instability of the PbTe:In, Ga lattice. *1997 Materials Research Society Fall Meeting*, Boston, USA, December 1997, Abstracts, p. 172.
100. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, A.V.Nikorich, W.Konig. Vibrational spectroscopy of indium-doped $Pb_{0.9}Mn_{0.1}Te$ alloy. *Zeitschrift fur Physik B*, **104** 475-479 (1997).
101. M.Romcevic, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, N.Romcevic. Optical properties of gallium - doped PbTe. *V International Workshop on High-Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials*, Moscow, Russia, March 1998, Abstracts, p. S5.
102. M.Romcevic, D.R.Khokhlov, L.I.Ryabova, B.Babic Stojic, N.Romcevic. Far-infrared and raman spectroscopy of localized states in chrome-doped PbTe. *V International Workshop on High-Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials*, Moscow, Russia, March 1998, Abstracts, p. S6.
103. I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, S.V.Ponomarev, E.I.Slyn'ko, A.A.Terekhov, A. de Visser, Yu.K.Vygranenko. Fermi level pinning effect in PbTe(Yb). *24 International Conference on the Physics of Semiconductors*, Jerusalem, Israel, August 1998, Abstracts, v.2, p.Th1-D3.
104. N.Romcevic, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, M.Romcevic. Raman spectra of indium and gallium - doped PbTe. *24 International Conference on the Physics of Semiconductors*, Jerusalem, Israel, August 1998, Abstracts, **2**, p.Th-P16.
105. А.И.Белогорохов, И.И.Иванчик, З.Попович, Н.Ромчевич, Д.Р.Хохлов. Структура DX-подобных центров в узкозонных полупроводниках $A^{IV}B^{VI}$, легированных элементами III группы. *ФТП*, **32** 679-684 (1998).
106. N.Romcevic, Z.V.Popovic, D.R.Khokhlov. Vibrational spectroscopy of impurity states in IV-VI narrow-band semiconductors. *Solid State Phenomena*, **61-62** 81-90 (1998).
107. D.R.Khokhlov, S.N.Chesnokov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik. Far-infrared high-performance lead telluride-based photodetectors for spaceborne applications. *Proc. SPIE*, **3354** 373-382 (1998).
108. D.R.Khokhlov. Sensitive mid- and far-infrared lead telluride-based photodetectors. *Proc. SPIE*, **3379** 608-617 (1998).
109. M.O.Manasreh, A.M.Mousalitin, D.R.Khokhlov. Electron irradiation effects on intersubband transitions in InGaAs/AlGaAs multiple quantum wells. *1998 Materials Research Society Fall Meeting*, Boston, USA, December 1998, Abstracts, H4.5.
110. D.Khokhlov. New type of infrared photodetectors based on lead telluride and related alloys. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **484** 295-300 (1998).

111. A.Belgorokhov, I.Ivanchik, D.Khokhlov. PbTe(Ga) - new multispectral infrared photodetector. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **484** 301-306 (1998).
112. A.I.Belgorokhov, L.I.Belgorokhova, D.R.Khokhlov. Nonmonotonous behaviour of temperature dependence of plasma frequency and effect of a local instability of the PbTe:In, Ga lattice. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **484** 383-388 (1998).
113. N.Romcevic, M.Romcevic, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik. Optical properties of gallium - doped PbTe. In: «*High-Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials*», ed. G. Van Tendeloo et al., 1999 Kluwer Academic Publ., p. 297-302.
114. M.O.Manasreh, H.J. von Bardeleben, A.M.Mousalitin, D.R.Khokhlov. Electron irradiation effects on the intersubband transitions in InGaAs/AlGaAs multiple quantum wells. *J. Appl. Phys.*, **85** 630-632 (1999).
115. I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, S.V.Ponomarev, E.I.Slyn'ko, A.A.Terekhov, A. de Visser, Yu.K.Vygranenko. Fermi level pinning effect in PbTe(Yb). *Proceedings of the 24 International Conference on the Physics of Semiconductors, Jerusalem, Israel, August 1998*, ed. D. Gershoni, World Scientific, CD-ROM, VIII B-8 (1999).
116. N.Romcevic, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, M.Romcevic. Raman spectra of indium and gallium - doped PbTe. *Proceedings of the 24 International Conference on the Physics of Semiconductors, Jerusalem, Israel, August 1998*, ed. D. Gershoni, World Scientific, CD-ROM, II C-19 (1999).
117. A.I.Belgorokhov, I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, S.V.Ponomarev. Peculiarities of PbTe(Ga) photoconductivity spectra in the middle- and far-infrared. *Proceedings of the 24 International Conference on the Physics of Semiconductors, Jerusalem, Israel, August 1998*, ed. D. Gershoni, World Scientific, CD-ROM, VIII B-26 (1999).
118. I.Ivanchik, D.Khokhlov, J.Pipher, N.Raines, D.Watson. Responsivity and spectral characteristics of far-infrared Pb_{1-x}Sn_xTe(In) photodetectors. *Third International School-Conference on Physical Problems in Material Science of Semiconductors*, Chernovtsi, Ukraine, September 1999, Abstracts, p. 232.
119. I.Ivanchik, D.Khokhlov, J.Pipher, N.Raines, D.Watson. Responsivity and spectral characteristics of far-infrared Pb_{1-x}Sn_xTe(In) photodetectors. *9-th International Conference on the Physics of Narrow-Gap Semiconductors*, Berlin, Germany, September 1999, Abstracts, p. 30.
120. И.И.Иванчик, Дж.Пайфер, Н.Рэйнс, Д.Уотсон, Д.Р.Хохлов. Прямое сравнение параметров инфракрасных фотоприемников на основе Pb_{1-x}Sn_xTe(In) и ВІВ структур Si(Sb) и Ge(Ga). *IV Российская конференция по физике полупроводников*, Новосибирск, октябрь 1999, тезисы докладов, с. 339.
121. I.Ivanchik, D.Khokhlov, J.Pipher, N.Raines, D.Watson. Performance and spectral characteristics of far-infrared Pb_{1-x}Sn_xTe(In) photodetectors. *1999 Materials Research Society Fall Meeting*, Boston, USA, November 1999, Abstracts, 004.6, p. 707.
122. N.Romcevic, M.Romcevic, I.Ivanchik, D.Khokhlov. Far-infrared study of impurity local modes in gallium-doped PbTe. *Infrared Physics and Technology*, **40** 453-462 (1999).
123. M.Romcevic, D.R.Khokhlov, N.Romcevic. Gallium doping influence on optical and transport properties of PbTe. *Materials Science Forum*, **352** 231-240 (2000).
124. D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, S.N.Raines, D.M.Watson, J.L.Pipher. Performance and spectral response of Pb_{1-x}Sn_xTe(In) far-infrared photodetectors. *Appl. Phys. Lett.*, **76** 2835-2837 (2000).
125. А.И.Белогорохов, Б.А.Волков, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Модель DX-подобных примесных центров в PbTe(Ga). *Письма в ЖЭТФ*, **72** 178-182 (2000).

126. I.I.Ivanchik, D.R.Khokhlov, A.V.Morozov, A.A.Terekhov, E.I.Slyn'ko, V.I.Slyn'ko, A. de Visser, W.D.Dobrowolski. Giant negative magnetoresistance effect in PbTe(Yb,Mn). *Phys. Rev. B*, **61** R14889-R14892 (2000).
127. D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik, J.L.Pipher, S.N.Raines, D.M.Watson. Responsivity and spectral characteristics of far-infrared Pb_{1-x}Sn_xTe(In) photodetectors. *Proceedings of the 9-th International Conference on Narrow-Gap Semiconductors, Berlin, September, 1999*, ed. N.Puhlmann, H.-U.Mueller, M. Von Ortenberg; Magnetotransport, Humboldt University at Berlin, Germany, p.81-83 (2000).
128. D.Khokhlov. Non-equilibrium phenomena in doped IV-VI semiconductors and related theoretical studies. *National High Magnetic Field Laboratory, Annual 1999 Report*, Tallahassee, FL, USA, p.127 (2000).
129. Д.Е.Долженко, В.Н.Демин, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов. Неустойчивость DX-подобных примесных центров в PbTe(Ga) при отжиге. *ФТП*, **34** 1194-1196 (2000).
130. M.Romcevic, N.Romcevic, D.R.Khokhlov, I.I.Ivanchik. Raman spectroscopy of impurity states in gallium-doped PbTe. *J. Phys.: Cond. Matt.*, **12** 8737-8744 (2000).
131. D.R.Khokhlov, S.N.Raines, D.M.Watson, I.I.Ivanchik, J.L.Pipher. Pb_{1-x}Sn_xTe(In) far-infrared photodetectors: a challenge to doped Si and Ge. *25th International Conference on the Physics of Semiconductors*, Osaka, Japan, September 17-22, 2000, Abstracts, part II, p. 633.
132. D.R.Khokhlov, A.V.Morozov, A.A.Terekhov, I.I.Ivanchik, E.I.Slyn'ko, V.E.Slyn'ko, W.D.Dobrowolski, A. de Visser. Giant negative magnetoresistance effect in PbTe(Yb,Mn). *25th International Conference on the Physics of Semiconductors*, Osaka, Japan, September 17-22, 2000, Abstracts, part III, p. 922.
133. I.Ivanchik, D. Khokhlov, J.Pipher, N.Raines, D.Watson. Performance and spectral response of far-infrared Pb_{1-x}Sn_xTe(In) photodetectors. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **607** 169-174 (2000).
134. D.Khokhlov, I.Ivanchik, N.Raines, D.Watson, J.Pipher. Performance of a Pb_{1-x}Sn_xTe(In) far-infrared photodetector in comparison with the state of the art Si(Sb) and Ge(Ga) analogs. *Bull. of the American Phys. Society*, March Meeting 2001, March 12-16, 2001, Seattle, WA, v. 46, part I, p.441.
135. D.R.Khokhlov, S.N.Raines, D.M.Watson, I.I.Ivanchik, J.L.Pipher. Pb_{1-x}Sn_xTe(In) far-infrared photodetectors: a challenge to doped Si and Ge. *Proceedings of the 25th International Conference on the Physics of Semiconductors*, ed. N. Miura, T. Ando, *Springer Proceedings in Physics*, vol. 87, part II, p. 1791-1792 (2001).
136. D.R.Khokhlov, A.V.Morozov, A.A.Terekhov, I.I.Ivanchik, E.I.Slyn'ko, V.E.Slyn'ko, W.D.Dobrowolski, A. de Visser. Giant negative magnetoresistance effect in PbTe(Yb,Mn). *Proceedings of the 25th International Conference on the Physics of Semiconductors*, ed. N. Miura, T. Ando, *Springer Proceedings in Physics*, vol. 87, part II, p. 1429-1430 (2001).
137. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Новый тип чувствительных фотоприемных материалов дальнего инфракрасного диапазона. *Всероссийская конференция «Необратимые процессы в природе и технике»*, 23-25 января 2001 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, тезисы докладов, с. 324-325.
138. И.И.Иванчик, А.Е.Кожанов, А.В.Морозов, Д.Р.Хохлов, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько, В.Д.Добровольски, Т.Стори. Отрицательное магнитосопротивление в PbTe(Mn,Cr). *5 Российская конференция по физике полупроводников*, 10-14 сентября 2001 г., Нижний Новгород, тезисы докладов, т.1, с. 33.

139. D.Khokhlov, I.Ivanchik, A.Kozhanov, A.Morozov, E.Slynko, V.Slynko, W.Dobrowolski, T.Story. Negative magnetoresistance in PbTe(Mn,Cr). *4-th Conf. on the Physical Phenomena in High Magnetic Fields*, 19-25 October 2001, Santa-Fe, USA, Abstracts, p.177.
140. D.Dolzhenko, I.Ivanchik, D.Khokhlov, K.Kristovskiy. Lead telluride-based far-infrared photodetectors – a promising alternative to doped Si and Ge. *2001 Materials Research Society Fall Meeting*, 26-30 November 2001, Boston, USA, Abstracts, p.145.
141. Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, К.Г.Кристовский, Д.Р.Хохлов. Фотоприемники дальнего ИК-диапазона на базе легированных сплавов теллурида свинца. *Всероссийская научная конференция «Физика полупроводников и полуметаллов»*, Санкт-Петербург, 4-6 февраля 2002 г., тезисы докладов, с. 170-171.
142. D.Khokhlov. Peculiarities of the impurity states in the narrow gap lead telluride – based semiconductors. *XVI Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников «Электронные свойства низкоразмерных полу- и сверхпроводниковых структур»*, Екатеринбург, 18-22 февраля 2002 г., тезисы докладов, с. L14.
143. А.И.Белогорохов, Л.И.Белогорохова, Д.Р.Хохлов, С.В.Лемешко. Смешанные оптические моды колебаний в нанокристаллитах PbTe. *ФТП*, **36** 701-708 (2002).
144. D.Dolzhenko, I.Ivanchik, D.Khokhlov, K.Kristovskiy. Lead telluride-based far-infrared photodetectors – a promising alternative to doped Si and Ge. *Materials Research Society Symposia Proceedings*, **692** 187-192 (2002).
145. Б.А.Волков, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Примеси с переменной валентностью в твердых растворах на основе теллурида свинца. *УФН*, **172** 875-906 (2002).
146. Б.А.Акимов, Д.Р.Хохлов. Фотоэлектрические характеристики модифицированных сплавов халькогенидов свинца. *Вопросы радиоэлектроники, сер. общетехническая*, вып. 2, с. 33-36 (2002).
147. A.Morozov, A.Artamkin, A.Kozhanov, I.Ivanchik, E.Slyn'ko, V.Slyn'ko, W.D.Dobrowolski, T.Story, D.Khokhlov. Negative Magnetoresistance Effect in $Pb_{1-x}Mn_xTe(Cr)$ and $Pb_{1-x}Mn_xTe(Yb)$. *26-th International Conference on the Physics of Semiconductors*, Edinburgh, UK, 29 July – 2 August 2002, Abstracts, vol.1, p.77.
148. N.Romcevic, D.R.Khokhlov, D.Stojanovic, M.Romcevic, A.V.Nikorich. DX-like centers and persistent photoconductivity effect in indium doped PbTe based alloys. *10th International Conference on Shallow-level in Semiconductors*. Warsaw, July 24-27, 2002, Program & Abstracts, Sa-P5, pp.101.
149. Б.А.Акимов, И.И.Иванчик, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, А.И.Белогорохов, Е.И.Слынько. Спектр фотопроводимости PbTe(Ga). *"Нанофотоника"*, Материалы совещания, Н.Новгород, 2002, с.63-66.
150. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Новый тип полупроводниковых материалов для фотоприемников инфракрасного и субмиллиметрового диапазонов. *Физическая мысль России*, **1/2-2002**, вып.2, с. 84-98 (2002).
151. D.Khokhlov, I.Ivanchik, A.Kozhanov, A.Morozov, E.Slynko, V.Slynko, W.Dobrowolski, T.Story. Negative magnetoresistance in PbTe(Mn,Cr). *Proceedings of Physical Phenomena at High Magnetic Fields – IV*. Editors: G. Voebinger, Z. Fisk, L. P. Gor'kov, A. Lacerda, and J. R. Schriffer. World Scientific (2002), p.451-454.

152. D.Khokhlov, I.Ivanchik, A.Kozhanov, A.Morozov, E.Slynko, V.Slynko, W.Dobrowolski, T.Story. Negative magnetoresistance in PbTe(Mn,Cr). *International Journal of Modern Physics B*, **16** 3343-3346 (2002).
153. Б.А.Акимов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Энергетические спектры и неравновесные состояния в твердых растворах на основе теллурида свинца. *Вестник РФФИ*, №4(30) 14-48 (2002).
154. B.Akimov, N.Brandt, L.Ryabova, D.Khokhlov. Lead telluride-based far-infrared photodetectors – a promising alternative to doped Si and Ge. *Bull. of the V.Tarasov Center of Chemtronics of Glass*, #2, 2002, p.52-57.
155. *Lead Chalcogenides: Physics and Applications. Vol.18 of the Book Series: Optoelectronic Properties of Semiconductors and Superlattices*, ed. D.Khokhlov. Taylor&Francis Books, Inc., 2003, 720 p.
156. D.Khokhlov. Infrared photodetectors based on doped lead tellurides. In: *Lead Chalcogenides: Physics and Applications. Vol.18 of the Book Series: Optoelectronic Properties of Semiconductors and Superlattices*, ed. D.Khokhlov. Taylor&Francis, 2003, p.617-642.
157. К.Г.Кристовский, А.Е.Кожанов, Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, Д.Р.Хохлов, Д.Уотсон. Фотопроводимость легированных сплавов на основе теллурида свинца в субмиллиметровом диапазоне. *Материалы совещания «Нанофотоника»*, Нижний Новгород, 17-20 марта 2003 г., т.1, с.67-70.
158. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Перспективная альтернатива современным высокочувствительным фотоприемникам инфракрасного диапазона. *Перспективные материалы*, №4 5-20 (2003).
159. D.Khokhlov, D.Dolzhenko, I.Ivanchik, K.Kristovskiy, D.Watson, J.Pipher, J.Wolf. Lead telluride-based photodetectors – a promising alternative to doped Si and Ge. *Proceedings of Far-IR, Sub-MM and MM Detector Technology Workshop*, Monterey, California, USA, 1-3 April, 2002, p.380-383 (2003).
160. D.Khokhlov, B.Volkov. Fermi level pinning and long-term relaxation effects in the doped IV-VI narrow-gap semiconductors. *Russian-Israeli Conference "Frontiers in Condensed Matter Physics"*, Shores, Israel, 19-24 October 2003, Abstracts, p.70-71.
161. А.И.Артакин, А.Е.Кожанов, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько, W.D.Dobrowolski, T.Story, Д.Р.Хохлов. Транспортные и магнитные свойства сплавов PbTe(Mn,Cr). *VI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 27-31 октября 2003, тезисы докладов, с.72-73.
162. К.Г.Кристовский, А.Е.Кожанов, Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, Д.Уотсон, Д.Р.Хохлов. Фотопроводимость легированных сплавов на основе теллурида свинца в дальнем инфракрасном диапазоне. *VI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 27-31 октября 2003, тезисы докладов, с.103-104.
163. Б.А.Акимов, В.В.Прядун, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Импеданс твердых растворов на основе теллурида свинца с примесью галлия. *VI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 27-31 октября 2003, тезисы докладов, с.414-415.
164. А.И.Белогорохов, Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, А.Е.Кожанов, Д.Р.Хохлов. Спектры быстрой части фотопроводимости в твердых растворах на основе PbTe(In) и PbTe(Ga). *VI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 27-31 октября 2003, тезисы докладов, с.434-435.

165. А.В.Морозов, А.Е.Кожанов, А.И.Арташкин, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько, W.D.Dobrowolski, T.Story, Д.Р.Хохлов. Стабилизация уровня Ферми и отрицательное магнитосопротивление в PbTe(Mn,Cr). *ФТП*, **38** 30-33 (2004).
166. Б.А.Акимов, В.В.Прядун, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Импеданс твердых растворов на основе теллурида свинца, легированного галлием. *ФТП*, **38** 293-295 (2004).
167. К.Г.Кристовский, А.Е.Кожанов, Д.Е.Долженко, И.И.Иванчик, D.Watson, Д.Р.Хохлов. Фотопроводимость легированных сплавов на основе теллурида свинца в субмиллиметровом диапазоне. *ФТТ*, **46** 123-125 (2004).
168. Б.А.Акимов, В.В.Прядун, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, В.И.Штанов. О связи задержанной фотопроводимости с фазовым переходом в легированных твердых растворах на основе теллурида свинца. *XV Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников*, Екатеринбург-Кыштым, 16-21 февраля 2004, тезисы докладов, с.87.
169. D.Khokhlov. Peculiarities of the impurity states in the narrow-gap lead telluride-based semiconductors. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, Санкт-Петербург-Зеленогорск, 27 февраля-1 марта 2004, тезисы докладов, с.61-67.
170. Б.А.Акимов, В.А.Васильков, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Рекомбинация на примесных центрах с переменной валентностью в эпитаксиальных слоях PbTe(Ga). *Материалы совещания «Нанопотоника»*, Нижний Новгород, 2-6 мая 2004, с.63-66.
171. Б.А.Акимов, В.В.Прядун, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Неравновесные процессы и сегнетоэлектрический фазовый переход в PbGeTe(Ga). *Материалы совещания «Нанопотоника»*, Нижний Новгород, 2-6 мая 2004, с.364-367.
172. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Новый тип материалов для высокочувствительных инфракрасных фотоприемников. *XVIII Международная конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения*, Москва, 25-28 мая 2004, с. 104.
173. Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Проблема примесных состояний в узкощелевых полупроводниках на основе теллурида свинца. *Письма в ЖЭТФ*, **80** 143-149 (2004).
174. D.Khokhlov, B.Volkov. Fermi level pinning and long-term relaxation effects in doped IV-VI narrow-gap semiconductors. *HAIT Journal of Science and Engineering*, **1** 266-273 (2004).
175. D.Khokhlov. Doped lead telluride-based semiconductors: new possibilities for detection of Terahertz radiation. *Int. J. Mod. Phys. B*, **18** 2223-2245 (2004).
176. A.I.Artamkin, A.E.Kozhanov, M.Arciszewska, W.D.Dobrowolski, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, D.R.Khokhlov. Transport and magnetic properties of Pb_{1-x}Mn_xTe doped with Cr and Mo. *Acta Phys. Pol.*, **106** 223-231 (2004).
177. Б.А.Акимов, В.В.Прядун, Л.И.Рябова, Е.И.Слынько, Д.Р.Хохлов, В.И.Штанов. Неравновесные процессы и сегнетоэлектрический фазовый переход в кристаллах PbGeTe(Ga). *ФНТ*, **30** 1209-1213 (2004).
178. A.Kozhanov, D.Dolzhenko, I.Ivanchik, D.Watson, D.Khokhlov. Submillimeter radiation-induced persistent photoconductivity in Pb_{1-x}Sn_xTe(In). *27 International Conference on the Physics of Semiconductors*, Flagstaff, Arizona, USA, 26-30 July 2004, Abstracts, p.318.
179. A.I.Artamkin, A.E.Kozhanov, M.Arciszewska, W.D.Dobrowolski, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, D.R.Khokhlov. Transport and magnetic properties of PbMnTe doped with Cr, Mo. *20 General Conference of the Condensed Matter Division of EPS*, Prague, Czech Republic, 19-23 July 2004, Abstracts, p.133.

180. D.Khokhlov. The problem of impurity states in the narrow-gap IV-VI semiconductors. *2 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Kishinev, Moldova, 21-26 September 2004, Abstracts, p.19.
181. A.I.Artamkin, A.E.Kozhanov, M.Arciszewska, W.D.Dobrowolski, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Transport and magnetic properties of $Pb_{1-x}Mn_xTe$ doped with Cr, Mo. *2 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Kishinev, Moldova, 21-26 September 2004, Abstracts, p.23.
182. B.A.Akimov, D.R.Khokhlov, V.V.Pryadun, L.I.Ryabova. Ferroelectric phase transition and impurity-lattice correlations in $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$. *2 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Kishinev, Moldova, 21-26 September 2004, Abstracts, p.63.
183. Е.И.Слынько, Д.Р.Хохлов, W.D.Dobrowolski, V.Domuchovski, P.Dziawa, В.Е.Слынько. Исследование новых твердых растворов $Pb_{1-x}Si_xTe$ и $Sn_{1-x}Si_xTe$. II Украинская научная конференция по физике полупроводников, Черновцы, Украина, 20-24 сентября 2004 г., тезисы докладов, т.2, с. 96-97.
184. A.Kozhanov, D.Dolzhenko, I.Ivanchik, D.Watson, D.Khokhlov. Submillimeter radiation-induced persistent photoconductivity in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Proc. SPIE*, **5543** 258-261 (2004).
185. Б.А.Акимов, В.А.Богоявленский, В.А.Васильков, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Рекомбинация на примесных центрах с переменной валентностью в эпитаксиальных слоях $PbTe(Ga)$. *ФТТ*, **47** 160-163 (2005).
186. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Новый тип материалов для высокочувствительных инфракрасных фотоприемников. *Прикладная физика*, №2 58-63 (2005).
187. Б.А.Акимов, Н.Б.Брандт, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Новый тип высокочувствительных приемников излучения терагерцового диапазона. Вестник МГУ, сер. Физика, астрономия, №1 59-64 (2005).
188. A.Kozhanov, D.Dolzhenko, I.Ivanchik, D.Watson, D.Khokhlov. Submillimeter radiation-induced persistent photoconductivity in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Proceedings of the 27 International Conference on the Physics of Semiconductors*, Flagstaff, USA, 26-30 July 2004, *AIP Conference Proc.* **772B** 1202-1203 (2005).
189. A.I.Artamkin, M.Arciszewska, W.D.Dobrowolski, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. The influence of native defects on the clusterization of Mn in $PbTe$. *34 International School on the Physics of Semiconducting Compounds*, Jaszowiec, Poland, 4-10 June 2005, Abstracts, p. 60.
190. L.Ryabova, V.Pryadun, B.Akimov, D.Khokhlov. On the features of $PbTe(Ga)$ as a semiinsulating substrate material for IV-VI heterostructures. *12 International Conference on Narrow-Gap Semiconductors*, Toulouse, France, 3-7 July 2005, Abstracts, p.76.
191. A.E.Kozhanov, S.N.Chesnokov, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Peculiarities of conductivity of $PbSnTe(In)$ in the persistent photoconductivity regime. *12 International Conference on Narrow-Gap Semiconductors*, Toulouse, France, 3-7 July 2005, Abstracts, p.76.
192. A.E.Kozhanov, D.Dolzhenko, D.Watson, D.Khokhlov. Terahertz radiation-induced persistent photoconductivity in $PbSnTe(In)$. *12 International Conference on Narrow-Gap Semiconductors*, Toulouse, France, 3-7 July 2005, Abstracts, p.91.

193. D.Khokhlov. Mixed valence puzzle in doped IV-VI semiconductors and its applied output: high-performance Terahertz photodetectors. *24 International Conference on Low Temperature Physics*, Orlando, USA, 10-17 August 2005, Abstracts, p.111.
194. A.E.Kozhanov, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Low temperature impedance spectroscopy of $Pb_{1-x}Sn_xTe$ doped with a mixed valence impurity. *24 International Conference on Low Temperature Physics*, Orlando, USA, 10-17 August 2005, Abstracts, p.255.
195. Т.А.Комиссарова, Н.Н.Матросов, О.Крылюк, Т.Андерсон, Т.М.Бурбаев, А.И.Белогорохов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Электрофизические и оптические свойства пленок InN, выращенных методами HVPE и MOCVD. *7 Российская конференция по физике полупроводников*, Москва-Звенигород, 18-23 сентября 2005, тезисы докладов, с. 136.
196. А.Е.Кожанов, Л.И.Рябова, С.Н.Чесноков, Д.Р.Хохлов. Особенности свойств $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$ в переменном электрическом поле. *7 Российская конференция по физике полупроводников*, Москва-Звенигород, 18-23 сентября 2005, тезисы докладов, с. 138.
197. А.И.Артакин, М.Arciszewska, W.D.Dobrowolski, T.Story, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Влияние собственных дефектов на кластеризацию марганца в $Pb_{1-x}Mn_xTe$. *7 Российская конференция по физике полупроводников*, Москва-Звенигород, 18-23 сентября 2005, тезисы докладов, с. 304.
198. D.R.Khokhlov. The problem of impurity states in the narrow-gap IV-VI semiconductors. *Moldavian Journal of the Physical Sciences*, **4** 283-286 (2005).
199. А.Е.Кожанов, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Проводимость твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в переменном электрическом поле. *ФТП*, **40** 1047-1050 (2006).
200. Д.Р.Хохлов. Высокочувствительные приемники терагерцового излучения на основе нового класса полупроводниковых материалов. *УФН*, **176** 983-987 (2006).
201. Д.Р.Хохлов. Корреляционные эффекты в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$, индуцированные переменным электрическим полем. *Международная зимняя школа по физике полупроводников, С.-Петербург-Зеленогорск, 24-27 февраля 2006 г.*, Научная программа и тезисы докладов, с.9-11.
202. А.Е.Кожанов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Аномальные свойства твердых растворов $PbSnTe(In)$ в переменном электрическом поле. *XVI Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников*, Екатеринбург, 27 февраля – 4 марта 2006г., тезисы докладов, с. 134.
203. А.Е.Кожанов, С.Н.Чесноков, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Корреляционные эффекты в примесной подсистеме в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *XVI Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников*, Екатеринбург, 27 февраля – 4 марта 2006г., тезисы докладов, с. 153-154.
204. Т.А.Комиссарова, Н.Н.Матросов, Л.И.Рябова, Т.М.Бурбаев, А.И.Белогорохов, J.Mangum, T.W.Kim, O.Kryliouk, T.Anderson, Д.Р.Хохлов. Оптические и электрофизические свойства InN. *XVI Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников*, Екатеринбург, 27 февраля – 4 марта 2006г., тезисы докладов, с. 115-116.
205. А.И.Артакин, Т.В.Ганжина, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько, Т.Story, P.Dziawa, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Транспортные свойства $Pb_{1-x}Mn_xTe(V)$. *XVI Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников*, Екатеринбург, 27 февраля – 4 марта 2006г., тезисы докладов, с. 159.

206. А.Е.Кожанов, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Корреляционные процессы, индуцированные переменным электрическим полем, в твердых растворах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Материалы X симпозиума «Нанопизика и Нанозлектроника»*, Нижний Новгород, 13-17 марта 2006г., т.1, с.126-128.
207. A.E.Kozhanov, S.N.Chesnokov, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Peculiarities of conductivity of $PbSnTe(In)$ in the persistent photoconductivity regime. *Proceedings of the 12th International Conference on Narrow Gap Semiconductors*, edited by J.Kono and J.Leotin, Published in 2006 by CRC Press Taylor&Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, **187**, 179-183.
208. A.I.Artamkin, A.A. Dobrovolskiy, P.Dziawa, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Features of Energy Spectrum of $Pb_{1-x}Mn_xTe$ Doped with V. *XXXV International School on the Physics of Semiconducting Compounds*, Jaszowiec, Poland, June 17-23, 2006, Abstracts, p.183.
209. A.E.Kozhanov, A.V.Nikorich, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Low frequency dielectric anomaly in $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$. *28th International Conference on the Physics of Semiconductors*. Vienna, Austria, July 24-28, 2006, Program, p.296.
210. A.I.Artamkin, A.A. Dobrovolskiy, P.Dziawa, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Transport properties of $PbTe(Mn)$ and $PbTe(Mn,V)$. *28th International Conference on the Physics of Semiconductors*. Vienna, Austria, July 24-28, 2006, Program, p.297.
211. A.Artamkin, A.Nikorich, V.Shklover, L.Ryabova, D.Khokhlov. Continuous focal-plane array for detection of Terahertz radiation. *28th International Conference on the Physics of Semiconductors*. Vienna, Austria, July 24-28, 2006, Program, p.253.
212. А.Е.Кожанов, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Низкочастотная диэлектрическая аномалия в твердых растворах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *34 Собрание по физике низких температур (НТ-34)*. Ростов-на-Дону, п. Лоо, 26-30 сентября 2006 г., труды собрания, т.2, с.93-94.
213. Д.Р.Хохлов. Проблема примесных состояний в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *34 Собрание по физике низких температур (НТ-34)*. Ростов-на-Дону, п. Лоо, 26-30 сентября 2006 г., труды собрания, т.2, с.20.
214. D.R.Khokhlov. The problem of impurity states in the IV-VI semiconductors. *3-rd International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Chisinau, Moldova, October 3-6, 2006, Abstracts, p.23.
215. A.E.Kozhanov, E.V.Bogdanov, A.V.Nikorich, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Photoconductivity of $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$ solid solution in alternating electric field. *3-rd International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Chisinau, Moldova, October 3-6, 2006, Abstracts, p.83.
216. N.Matrosov, T.Komissarova, L.Ryabova, D.Khokhlov, V.Jmerik, S.Ivanov. Electrophysical properties of solid solutions $In_xGa_{1-x}N$. *3-rd International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Chisinau, Moldova, October 3-6, 2006, Abstracts, p.103.
217. В.А.Акимов, Д.Р.Хохлов, В.В.Прыдун, Л.И.Рябова. Ферроэлектрический фазовый переход и примесно-решеточные корреляции в $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$. *Moldavian Journal of Physics*, **5**, 32-36 (2006).
218. A.Artamkin, A.Nicorici, L.Ryabova, V.Shklover, D.Khokhlov. Continuous focal plane array for detection of Terahertz radiation. *Proc. SPIE*, **6257**, 6257OB-1-6257OB-5 (2006).

219. А.И.Белогорохов, И.А.Белогорохов, М.И.Василевский, С.А.Гаврилов, R.P.Miranda, X.Диттрих, Д.Р.Хохлов, Поглощение ИК излучения полярными оптическими фононами в массиве нанокристаллов CdS, состоящем из квантовых точек и квантовых нитей *Письма в ЖЭТФ*, **84**, 152-155 (2006).
220. A.I.Artamkin, A.A. Dobrovolskiy, P.Dziawa, T.Story, E.I.Slynko, V.E.Slynko, L.I.Ryabova, D.R.Khokhlov. Features of Energy Spectrum of $Pb_{1-x}Mn_xTe$ Doped with V. *Acta Physica Polonica A*, **110**, 151-156 (2006).
221. A.E.Kozhanov, D.E.Dolzhenko, I.I.Ivanchik, D.M.Watson, D.R.Khokhlov. Submillimeter radiation-induced persistent photoconductivity in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. In: *Springer NATO Science Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry*, ed. R. Gross, A. Sidorenko, L.Tagirov, v.233, p.319-324 (2006).
222. Т.А.Комиссарова, Н.Н.Матросов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, В.Н.Жмерик, С.В.Иванов. Электрофизические свойства твердых растворов $In_xGa_{1-x}N$. 5 *Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы»*, Москва, 31 января – 2 февраля 2007 г., тезисы докладов, с.123-124.
223. А.Е.Кожанов, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, V.Shklover. Кинетика фотопроводимости $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в переменном электрическом поле. *XI Международный симпозиум «Нанозфизика и нанозлектроника»*, Нижний Новгород, 10-14 марта 2007 г., Труды симпозиума, т.1, с.133-135.
224. D.Khokhlov, B.Akimov, L.Ryabova, A.Nicorici, V.Shklover. Sensitive focal plane arrays for detection of Terahertz radiation based on the doped IV-VI narrow gap semiconductors. *International Conference on Nano Science and Technology (ICN+T 2007)*, Stockholm, Sweden, 2-6 July 2007, Abstract CD-ROM, abstract # EMP10-Or4.
225. Т.Комиссарова, В.Акимов, Z.Dashevski, V.Kasiyan, D.Khokhlov, L.Ryabova. Photoconductivity of nanocrystalline $PbTe(In)$ films in alternating electric field. *International Conference on Nano Science and Technology (ICN+T 2007)*, Stockholm, Sweden, 2-6 July 2007, Abstract CD-ROM, abstract # EMP09-Or2.
226. Т.Комиссарова, Z.Dashevsky, V.Kasyan, D.Khokhlov, L.Ryabova. Impedance spectra of nanocrystalline $PbTe(In)$ films with variable grain size. *13 International Conference on Narrow Gap Semiconductors*, Guildford, Great Britain, 8-12 July 2007, Abstracts, p.85.
227. A.Dobrovolsky, A.Artamkin, P.Dziawa, T.Story, E.Slynko, V.Slynko, L.Ryabova, D.Khokhlov. Magnetic and transport properties of $Pb_{1-x}Mn_xTe$ solid solutions doped with V. *13 International Conference on Narrow Gap Semiconductors*, Guildford, Great Britain, 8-12 July 2007, Abstracts, p.94.
228. D.R.Khokhlov. Sensitive detectors of terahertz radiation based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *SPIE Optics+Photonics 2007*, San Diego, CA, USA, 26-30 August 2007, Abstracts, p.313.
229. Sang Won Kang, Hyun Jong Park, Yong Sun Won, O.Kryliouk, T.Anderson, D.Khokhlov, T.Burbaev. Prevention of In droplets formation by HCl addition during metal organic vapor phase epitaxy of InN. *Appl. Phys Lett.* **90**, 161126-1-3 (2007).
230. Hyun Jong Park, O.Kryliouk, T.Anderson, D.Khokhlov, T.Burbaev. Growth of InN films and nanorods by H-MOVPE. *Physica E* **37**, 142-147 (2007).
231. И.А.Белогорохов, М.Н.Мартышов, Е.В.Тихонов, М.О.Бреусова, В.Е.Пушкарев, П.А.Форш, А.В.Зотеев, Л.Г.Томилова, Д.Р.Хохлов. Вибронные и электрические свойства полупроводниковых структур на основе бутилзамещенных моно- и трифталоцианина, содержащих ионы эрбия. *Письма в ЖЭТФ*, **85**, 791-794 (2007).

232. И.А.Белогорохов, Е.В.Тихонов, М.О.Бреусова, В.Е.Пушкарев, А.В.Зотеев, Л.Г.Томилова, Д.Р.Хохлов. Комбинационное рассеяние в полупроводниковых структурах на основе молекул моно- и трифталоцианина, содержащих ионы эрбия. *ФТП*, **41**, 1381-1383 (2007).
233. T.Komissarova, D.Khokhlov, L.Ryabova, Z.Dashevsky, V.Kasiyan. Impedance of photosensitive nanocrystalline PbTe(In) films. *Phys. Rev. B*, **75**, 195326-1-5 (2007).
234. Т.А.Комиссарова, Н.Н.Матросов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, В.Н.Жмерик, С.В.Иванов. Особенности электрофизических свойств твердых растворов $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$. *ФТП*, **41**, 558-560 (2007).
235. А.Е.Кожанов, А.В.Никорич, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, А.В.Дмитриев, V.Shklover. Фотопроводимость твердого раствора $\text{Pb}_{0.75}\text{Sn}_{0.25}\text{Te}(\text{In})$ в переменном электрическом поле. *ФТП*, **41**, 683-686 (2007).
236. А.И.Арташкин, Д.Е.Долженко, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Считывание информации с «непрерывной» фокальной матрицы терагерцового диапазона на основе сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. 8 *Российская конференция по физике полупроводников*, Екатеринбург, 30 сентября – 5 октября 2007, тезисы докладов, с. 389.
237. И.А.Белогорохов, Е.В.Тихонов, М.О.Бреусова, В.Е.Пушкарев, А.В.Зотеев, Л.Г.Томилова, Д.Р.Хохлов. Исследование вибронных свойств полупроводниковых структур на основе молекул бутилзамещенного моно- бис- и трифталоцианина эрбия. 8 *Российская конференция по физике полупроводников*, Екатеринбург, 30 сентября – 5 октября 2007, тезисы докладов, с. 332.
238. Т.А.Комиссарова, В.Н.Жмерик, Т.В.Шубина, С.В.Иванов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Электрофизические свойства InN с In вставками. 8 *Российская конференция по физике полупроводников*, Екатеринбург, 30 сентября – 5 октября 2007, тезисы докладов, с. 57.
239. А.А.Добровольский, А.И.Арташкин, P.Dziawa, T.Story, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов. Импеданс-спектроскопия твердых растворов $\text{PbTe}(\text{Mn},\text{V})$. 8 *Российская конференция по физике полупроводников*, Екатеринбург, 30 сентября – 5 октября 2007, тезисы докладов, с. 58.
240. T.Komissarova, D.Plotnikov, V.Jmerik, T.Shubina, A.Mizerov, A.Semenov, S.Ivanov, L.Ryabova, D.Khokhlov. Electrical properties and optical absorption in periodic $\text{InN}:\text{In}$ structures. *7-th International Conference of Nitride Semiconductors*, Las Vegas, Nevada, USA, September 16-21, 2007, Technical Program, WP31.
241. N.Romcevic, J.Trajic, Т.А.Kuznetsova, M.Romcevic, M.Hadzic, D.R.Khokhlov. Far-infrared study of impurity local modes in Ni-doped PbTe. *Journal of Alloys and Compounds*, **442**, 324-327 (2007).
242. N.Romcevic, D.Stoyanovic, M.Romcevic, D.R.Khokhlov, M.Hadzic, A.V.Nikorich. Raman spectroscopy of $\text{Pb}_{0.75}\text{Sn}_{0.25}\text{Te}(\text{In})$ single crystal. *Journal of Alloys and Compounds*, **436**, 38-42 (2007).
243. А.В.Якимчук, Ю.В.Заикина, Л.Н.Решетова, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, А.В.Шевельков. Импеданс полупроводниковых клатратов $\text{Sn}_{24}\text{P}_{19,3}\text{Br}_x\text{I}_{8-x}$. *ФНТ*, **33**, 369-373 (2007).
244. И.А. Белогорохов, Ю.В. Рябчиков, Е.В. Тихонов, В.Е. Пушкарев, М.О. Бреусова, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Фотолюминесценция полупроводниковых структур на основе бутилзамещенных фталоцианинов эрбия. *ФТП*, **42**, 327-330 (2008).
245. Д.Р. Хохлов, Л.И. Рябова, Б.А. Акимов, А.В. Никорич, С.Д. Ганичев, С.В. Данилов, В.В. Бельков. Фотопроводимость в $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ при воздействии терагерцового лазерного

- излучения. *XVII Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 18-23 февраля 2008 г., тезисы докладов, с.107-108.
246. Д.Р. Хохлов. «Медленный» и «быстрый» терагерцовый фотоотклик в легированных узкощелевых полупроводниках на основе теллурида свинца. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, С.-Петербург – Зеленогорск, 26 февраля – 1 марта 2008 г., тезисы докладов, с.23-26.
247. Д.Р. Хохлов, Л.И. Рябова, Б.А. Акимов, А.В. Никорич, С.Д. Ганичев, С.В. Данилов, В.В. Бельков. Кинетика фотопроводимости в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ при воздействии мощного терагерцового лазерного излучения. *XII Международный симпозиум «Нанозлектроника и нанотехнологии»*, Нижний Новгород, 10-14 марта 2008 г., Труды симпозиума, т.1, с.17-18.
248. Т.А. Комиссарова, В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Н.М. Шмидт, Д.Р. Хохлов, С.В. Иванов, Электрические свойства GaN и $Al_xGa_{1-x}N$, легированных Mg . *6 Всероссийской конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы»*, 18-20 июня 2008 г., Санкт-Петербург, Россия, тезисы докладов, 179 (2008).
249. D. Khokhlov, L. Ryabova, A. Nicorici, S. Danilov, V. Bel'kov and S. Ganichev. Kinetics of photoconductivity induced by terahertz laser pulses in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *4th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Kishinev, Moldova, September 23-26, 2008, Abstracts, p. 20-20.
250. A.A. Dobrovolsky, A.I. Artamkin, P. Dziawa, T. Story, E.I. Slyn'ko, V.E. Slyn'ko, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov. Deep impurity levels in vanadium-doped $Pb_{1-x}Mn_xTe$ solid solutions. *Semicond. Sci. Technol.*, **23**, 055004 (6pp) (2008).
251. И.А. Белогорохов, М.Н. Мартышов, Е.В. Тихонов, М.О. Бреусова, В.Е. Пушкарев, П.А. Форш, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Особенности механизмов переноса носителей заряда в сформированных на поверхности кремния ансамблях полупроводниковых комплексов бутилзамещенного трифталоцианина, содержащих атомы эрбия. *Известия ВУЗов: Материалы электронной техники*, №1, 71-74 (2008).
252. Т.А. Комиссарова, D.S. Plotnikov, V.N. Jmerik, T.V. Shubina, A.M. Mizerov, A.N. Semenov, S.V. Ivanov, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov. Electrical properties and optical absorption in $InN:In$ structures. *Physica Status Solidi (c)*, **5**, 1621-1623 (2008).
253. V. Jovovic, S.J. Thiagarajan, J.P. Heremans, T. Komissarova, D. Khokhlov, and A. Nicorici. Low temperature thermal, thermoelectric, and thermomagnetic transport in indium rich $Pb_{1-x}Sn_xTe$ alloys. *J. Appl. Phys.* **103**, 053710 (2008) (7 pages).
254. Т.А. Комиссарова, T.V. Shubina, V.N. Jmerik, M.A. Timofeeva, N.A. Pikhtin, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov, P.S. Kop'ev, and S.V. Ivanov. Photovoltaic effect in InN films with In clusters. *Proceedings of 16th International Symposium on Nanostructures: Physics and Technology*, 64-65 (2008).
255. D. Khokhlov, L. Ryabova, A. Nicorici, V. Shklover, S. Ganichev, S. Danilov, V. Bel'kov. Terahertz photoconductivity of $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Appl. Phys. Lett.*, **93**, 264103 (2008) (3 pages).
256. Т.А. Комиссарова, T.V. Shubina, V.N. Jmerik, S.V. Ivanov, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov, A. Vasson, J. Leymarie, T. Araki, Y. Nanishi. Electrical and optical properties of InN with periodic metallic In insertions. *ФТП*, **43**, 304-307 (2009).
257. N. Romcevic, D. Stojanovic, M. Romcevic, D.R. Khokhlov. Raman spectroscopy of $Pb_{1-x}Sn_xTe$ (In) single crystals. *Journal of Alloys and Compounds*, **474**, 26-30 (2009).

258. A. Dobrovolsky, Z. Dashevsky, V. Kasiyan, L. Ryabova, D. Khokhlov. Low-temperature charge transport in photosensitive nanocrystalline PbTe(In) films. *Journal of Physics: Conference Series*, **150**, 022009 (6pp) (2009).
259. А.А. Добровольский, Т.А. Комиссарова, З.М. Дашевский, В.А. Касиян, Б.А. Акимов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Влияние окисления на проводимость нанокристаллических пленок PbTe(In) в переменном электрическом поле. *ФТП*, **42**, 265-268 (2009).
260. A.A. Dobrovolsky, Z.M. Dashevsky, V.A. Kasiyan, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov. Photoconductivity of oxidized nanostructured PbTe(In) films. *Semicond. Sci. Technol.*, **24**, 075010 (5 pp) (2009).
261. A. Dobrovolsky, T. Komissarova, B. Akimov, Z. Dashevsky, V. Kasiyan, D. Khokhlov, L. Ryabova. Charge transport in photosensitive nanocrystalline PbTe(In) films in an alternating electric field. *Int. J. Mat. Res.*, **100**, 1252-1254 (2009).
262. Д.Р. Хохлов, А.В. Галеева, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова. Новый класс высокочувствительных приемников терагерцового излучения. *Оптика и Спектроскопия*, **107**, 546-552 (2009).
263. Д.Р. Хохлов. Фотозлектрические явления в легированных сплавах на основе теллурида свинца под действием лазерного терагерцового излучения. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, С.-Петербург – Зеленогорск, 27 февраля – 2 марта 2009 г., тезисы докладов, с.29-30.
264. Д.Р. Хохлов, А.В. Галеева, Л.И. Рябова, А.В. Никорич, С.Д. Ганичев, С.В. Данилов, В.В. Бельков. Магнитофотогальванический эффект в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ при воздействии мощного терагерцового лазерного излучения. *XIII Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»*, Нижний Новгород, 16-20 марта 2009 г., Труды симпозиума, т.1, с.76-77.
265. А.А. Добровольский, В.И. Черничкин, Z. Dashevsky, V. Kasiyan, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Импеданс-спектроскопия фоточувствительных наноструктур на основе PbTe(In). *XIII Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»*, Нижний Новгород, 16-20 марта 2009 г., Труды симпозиума, т.2, с.328-329.
266. A. Dobrovolsky, I. Belogorokhov, Z. Dashevsky, V. Kasiyan, L. Ryabova, D. Khokhlov. Optical and transport properties of nanostructured PbTe(In) films. *Proc. SPIE*, **7404**, 74040S (6 pages) (2009).
267. D. Khokhlov, D. Dolzhenko, L. Ryabova, A. Nicorici, S. Ganichev, S. Danilov, V. Bel'kov. Photoconductive response of PbSnTe(In) in the terahertz spectral range. *Proc. SPIE*, **7453**, 74530J (6 pages) (2009).
268. L. Ryabova, A. Dobrovolsky, Z. Dashevsky, E. Shufer, D. Khokhlov. Grain size and oxidation effect on the impedance of nanocrystalline PbTe(In) films. *Showcasing Israeli Nanotechnology Conference & Exhibition*, Jerusalem, Israel, March 30-31, 2009, Abstract CD.
269. D. Khokhlov, L. Ryabova. High-performance terahertz photodetectors. *Showcasing Israeli Nanotechnology Conference & Exhibition*, Jerusalem, Israel, March 30-31, 2009, Abstract CD.
270. A. Dobrovolsky, V. Chernichkin, I. Belogorokhov, Z.M. Dashevsky, V.A. Kasiyan, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov. Transport properties and photoconductivity of nanocrystalline PbTe(In) films. *23rd International Conference on Amorphous and*

- Nanocrystalline Semiconductors*, Amsterdam, Netherlands, August 23-28, 2009, Abstracts, p. 168.
271. A. Dobrovolsky, R. Vasiliev, K. Drozdov, O. Maslova, M. Rummyantseva, A. Gaskov, L. Ryabova, D. Khokhlov. Optical and photoelectric properties of nanocrystalline SnO_2 – CdSe quantum dots structures. *23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors*, Amsterdam, Netherlands, August 23-28, 2009, Abstracts, p. 412.
272. А.А. Добровольский, А.И. Артамкин, А.А. Винокуров, В.П. Зломанов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов, О.М. Иваненко, К.В. Мицен. Корреляционные эффекты в PbTe, легированном ванадием. *IX Российская конференция по физике полупроводников (Полупроводники'09)*, 28 сентября - 3 октября 2009 г., Новосибирск-Томск, тезисы докладов, с.36.
273. А.А. Добровольский, В.И. Черничкин, З.М. Дашевский, В.А. Касиян, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Транспортные свойства и фотопроводимость нанокристаллических пленок PbTe(In). *IX Российская конференция по физике полупроводников (Полупроводники'09)*, 28 сентября - 3 октября 2009 г., Новосибирск-Томск, тезисы докладов, с.51.
274. Д.Р. Хохлов, А.В. Галеева, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова, А.В. Никорич, С.Д. Ганичев, С.Н. Данилов, В.В. Бельков. Фотоэлектрические эффекты в легированных полупроводниках на основе теллурида свинца при воздействии лазерного терагерцового излучения. *IX Российская конференция по физике полупроводников (Полупроводники'09)*, 28 сентября - 3 октября 2009 г., Новосибирск-Томск, тезисы докладов, с.249.
275. Е.В. Тихонов, И.А. Белогорохов, Д.Р. Хохлов, Л.Г. Томилова. Спектры комбинационного рассеяния света полупроводниковых структур на основе фталоцианина эрбия. *IX Российская конференция по физике полупроводников (Полупроводники'09)*, 28 сентября - 3 октября 2009 г., Новосибирск-Томск, тезисы докладов, с.262.
276. И.А. Белогорохов, Д.А. Мамичев, М.А. Дронов, В. Е. Пушкарев, Л. Г. Томилова, Д. Р. Хохлов. Комбинационное рассеяние света в органических полупроводниковых структурах на основе молекул бистфалоцианина эрбия и хлорсодержащих молекул трифталоцианина лютеция и европия. *Материалы XV Международной научно-технической конференции «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ». XII Международный симпозиум «ТОНКИЕ ПЛЕНКИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ»*, Москва, 9-11 сентября, 2009, с. 208-217.
277. А.А. Добровольский, В.И. Черничкин, И.А. Белогорохов, З.М. Дашевский, В.А. Касиян, А.И. Белогорохов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Особенности фотопроводимости наноструктур на основе PbTe(In) в переменных электрических полях. *Материалы электронной техники*, №4, 47-49 (2009).
278. А.В. Галеева, Л.И. Рябова, А.В. Никорич, С.Д. Ганичев, С.Н. Данилов, В.В. Бельков, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость узкощелевых полупроводников $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ в терагерцовой спектральной области. *Письма в ЖЭТФ*, **91**, 37-39 (2010).
279. Д.Р. Хохлов. Высокочувствительные приемники терагерцового излучения. *XVIII Уральская международная школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 15-20 февраля, 2010, тезисы докладов, с. 197-198.

280. А.В. Галеева, Ф.С. Напольский, С.Я. Истомина, Д.Р. Хохлов. Структура и транспортные свойства сложных оксидов $\text{Sr}_{0.75-x}\text{Ca}_x\text{Y}_{0.25}\text{Co}_{0.25}\text{Mn}_{0.75}\text{O}_{3-\delta}$ ($0 < x < 0.6$). *XVIII Уральская международная школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 15-20 февраля, 2010, тезисы докладов, с. 235-236.
281. Е.В. Тихонов, И.А. Белогорохов, Д.Р. Хохлов, Л.Г. Томилова. Расчет свойств молекул фталоцианина эрбия методом функционала плотности. *XVIII Уральская международная школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 15-20 февраля, 2010, тезисы докладов, с. 237.
282. Д.Р. Хохлов. Чувствительные приемники терагерцового излучения для космических и медицинских приложений. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, Санкт-Петербург-Зеленогорск, 25 февраля – 1 марта, 2010, тезисы докладов, с.33-34.
283. Д.Р. Хохлов. Высокочувствительные приемники терагерцового излучения для космических приложений. *XIV Международный симпозиум «Нанозфизика и наноэлектроника»*, Нижний Новгород, 15-19 марта, 2010, труды симпозиума, т.2, с.309-310.
284. Л.И. Рябова, А.А. Добровольский, А.В. Галеева, А.В. Никорич, З.М. Дашевский, В.А. Касиян, В.В. Бельков, С.Д. Ганичев, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость твердых растворов на основе $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. *XIV Международный симпозиум «Нанозфизика и наноэлектроника»*, Нижний Новгород, 15-19 марта, 2010, труды симпозиума, т.2, с.475-476.
285. И.А. Белогорохов, М.Н. Мартышов, Д.А. Мамичев, М.А. Дронов, В.Е. Пушкарев, Ю.В. Рябчиков, П.А. Форш, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Вибронные свойства органических полупроводников на основе фталоцианиновых комплексов с несимметричным распределением электронной плотности. *ФТП*, **44**, 795-800 (2010).
286. И.А. Белогорохов, Д.А. Мамичев, М.А. Дронов, В.Е. Пушкарев, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Комбинационное рассеяние света в органических полупроводниках на основе молекул дифталоцианина эрбия и хлорсодержащих молекул трифталоцианина лютеция и европия. *ФТП*, **44**, 1078-1083 (2010).
287. J. Trajić, N. Romčević, M. Romčević, D. Stojanović, R. Rudolf, T.A. Kuznetsova, D.R. Khokhlov. Far-infrared study of impurity local modes in Co-doped PbTe. *Journal of Alloys and Compounds*, **493**, 41-46 (2010).
288. N. Romčević, J. Trajić, M. Romčević, D. Stojanović, T.A. Kuznetsova, D.R. Khokhlov, W.D. Dobrowolski. Optical and magnetic properties of PbTe(Co). *Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications*, **4**, 470-475 (2010).
289. И.А. Белогорохов, М.А. Дронов, Е.В. Тихонов, В.Е. Пушкарев, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Частотные зависимости мнимой и действительной частей диэлектрической проницаемости органических полупроводников на основе бутилзамещенных молекул монофталоцианина эрбия. *Письма в ЖЭТФ*, **91**, 676-679 (2010).
290. D.R. Khokhlov. Sensitive detectors of terahertz radiation based on $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$. *International Symposium “Terahertz radiation: generation and application”*, Novosibirsk, Russia, 26-29 July 2010, Digest Reports, p.9.

291. D. Khokhlov, D. Dolzhenko, L. Ryabova, E. Bogdanov, A. Nicorici. Sensitive detectors of terahertz radiation based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *5 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics*, Kishinev, Moldova, 13-17 September 2010, Abstracts, p.36.
292. D. Khokhlov. Sensitive direct detectors of terahertz radiation based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Workshop of International Network GDR-I "Semiconductor Sources and Detectors at THz Frequencies"*, Paris, France, 27-28 September 2010, Abstracts.
293. Д.Р. Хохлов. Чувствительные приемники терагерцового излучения на основе полупроводников IV-VI. *2 Российский симпозиум «Полупроводниковые лазеры: физика и технология»*, Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2010, тезисы докладов, с.46.
294. А.И. Артамкин, А.А. Добровольский, А.А. Винокуров, В.П. Зломанов, С.Ю. Гаврилкин, О.М. Иваненко, К.В. Мицен, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Особенности примесных состояний ванадия в теллуриде свинца. *ФТП*, **44**, 1591-1595 (2010).
295. D. Khokhlov. Detectors of terahertz radiation based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Proc. SPIE*, **7763**, 776308-1 – 776308-8 (2010).
296. A. Dobrovolsky, V. Chernichkin, I. Belogorokhov, Z. Dashevsky, V. Kasiyan, L. Ryabova, D. Khokhlov. Transport properties and photoconductivity of nanocrystalline $PbTe(In)$ films. *Phys. Stat. Sol. C*, **7**, 869-872 (2010).
297. A. Dobrovolsky, R. Vasiliev, K. Drozdov, O. Maslova, M. Rummyantseva, A. Gaskov, L. Ryabova, D. Khokhlov. Optical and photoelectric properties of nanocrystalline $SnO_2 - CdSe$ quantum dot structures. *Phys. Stat. Sol. C*, **7**, 972-975 (2010).
298. И.А. Белогорохов, Е.В. Тихонов, А.А. Добровольский, А.В. Галеева, А.И. Артамкин, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Теоретический расчет частот колебательных и вращательных переходов в органических полупроводниках на основе молекул безметалльного монофталоцианина. *Материалы электронной техники*, №4, 27-31 (2010).
299. Д.Р. Хохлов. Локальные состояния в легированных полупроводниках на основе теллурида свинца: новая физика и приложения. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, Санкт-Петербург-Зеленогорск, 25 - 28 февраля, 2011, тезисы докладов, с.17-21.
300. В.И. Черничкин, А.А. Добровольский, В.А. Касьян, А.В. Никорич, В.В. Бельков, С.Н. Данилов, Л.И. Рябова, З.М. Дашевский, С.Д. Ганичев, Д.Р. Хохлов. Терагерцовая фотопроводимость и новый тип локальных состояний в легированных сплавах на основе теллурида свинца. *XV Международный симпозиум «Нанофизика и нанoeлектроника»*, Нижний Новгород, 14-18 марта, 2011, труды симпозиума, т.1, с.62-63.
301. К.А. Дроздов, А.А. Добровольский, Р.Б. Васильев, А.В. Попело, М.Н. Румянцева, А.М. Гаськов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Оптические и фотоэлектрические свойства структур с квантовыми точками $CdSe/CdS$ (ядро-оболочка). *XIV Международный симпозиум «Нанофизика и нанoeлектроника»*, Нижний Новгород, 14-18 марта, 2011, труды симпозиума, т.2, с.472-473.
302. D.E. Dolzhenko, A.V. Nicorici, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov. Doped lead telluride-based alloys – a new type of sensitive detectors of terahertz radiation. *22 International Symposium on Sparse Terahertz Technology*, Tucson, AZ, USA, 26-28 April, 2011, Abstract Book, p.61.
303. D.E. Dolzhenko, L.I. Ryabova, A.V. Nicorici, D.R. Khokhlov. Sensitive detectors of terahertz radiation based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *19 International Symposium "Nanostructures: Physics and Technology"*, Ekaterinburg, Russia, 20-25 June, 2011, Proceedings, p.247-248.

304. D.E. Dolzhenko, V.I. Chernichkin, L.I. Ryabova, A.V. Nicorici, D.R. Khokhlov. Performance of sensitive terahertz photodetectors based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *8 International Workshop "Strong Microwave and Terhertz Waves: Sources and Applications"*, Nizhny Novgorod – St. Petersburg, Russia, 9-16 July 2011, Proceedings, p.213-214.
305. Д.Е. Долженко, В.И. Черничкин, Л.И. Рябова, А.В. Никорич, В.А. Касьян, З.М. Дашевский, С.Д. Ганичев, С.Н. Данилов, В.В. Бельков, Д.Р. Хохлов. Терагерцовая фотопроводимость и новый тип локальных состояний в легированных сплавах на основе теллурида свинца. *Российская конференция и школа по актуальным проблемам полупроводниковой нанофотозлектроники «Фотоника-2011»*, Новосибирск, 22-26 августа, 2011, тезисы докладов, с.17.
306. В.И. Черничкин, Л.И. Рябова, А.А. Добровольский, В.А. Касьян, З.М. Дашевский, С.Д. Ганичев, В.В. Бельков, Д.Р. Хохлов. Влияние микроструктуры на фотопроводимость пленок $PbTe(In)$. *X Российская конференция по физике полупроводников*, Нижний Новгород, 19-23 сентября, 2011, тезисы докладов, с.44.
307. Л.И. Рябова, В.И. Черничкин, А.А. Добровольский, В.А. Касьян, А.В. Никорич, З.М. Дашевский, С.Д. Ганичев, В.В. Бельков, Д.Р. Хохлов. Новый тип примесных состояний, ответственных за терагерцовую фоточувствительность твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *X Российская конференция по физике полупроводников*, Нижний Новгород, 19-23 сентября, 2011, тезисы докладов, с.178.
308. Д.Е. Долженко, В.И. Черничкин, Л.И. Рябова, А.В. Никорич, Д.Р. Хохлов. Высокочувствительные приемники терагерцового излучения на основе $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *X Российская конференция по физике полупроводников*, Нижний Новгород, 19-23 сентября, 2011, тезисы докладов, с.196.
309. М.А. Дронов, И.А. Белогорохов, Д.Р. Хохлов. Новые полимерные композитные материалы для энергонезависимой памяти на основе МЕН-PPV. *X Российская конференция по физике полупроводников*, Нижний Новгород, 19-23 сентября, 2011, тезисы докладов, с.201.
310. Е.В. Тихонов, Э.Т. Кулатов, Ю.А. Успенский, И.А. Белогорохов, Д.Р. Хохлов. Электронная структура, спиновая поляризация и геометрия молекул фталоцианинов, легированных атомами 3d-, 4d- и 5d- периодов. *X Российская конференция по физике полупроводников*, Нижний Новгород, 19-23 сентября, 2011, тезисы докладов, с.204.
311. И.А. Белогорохов, Е.В. Тихонов, М.А. Дронов, Л.И. Белогорохова, Ю.В. Рябчиков, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Особенности спектральных зависимостей пропускания в органических полупроводниках на основе молекул трет-бутилзамещенного дифталоцианина лютеция. *ФТП*, **45**, 1509-1513 (2011).
312. И.А. Белогорохов, Е.В. Тихонов, М.А. Дронов, Ю.В. Рябчиков, Н.В. Пашкова, Е.И. Кладова, Л.И. Белогорохова, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Исследование транспортных свойств органических полупроводников на основе дифталоцианиновых и би-трифталоцианиновых комплексов европия с орто-бис(оксиметил)фенильным мостиком, а также на основе комплексов динафталоцианина эрбия и европия. *ФТП*, **45**, 1514-1519 (2011).
313. В.И. Черничкин, А.А. Добровольский, З.М. Дашевский, В.А. Касиян, В.В. Бельков, С.Д. Ганичев, С.Н. Данилов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость пленок $PbTe(In)$ с варьируемой микроструктурой. *ФТП*, **45**, 1533-1537 (2011).
314. I.A. Belogorokhov, E.V. Tikhonov, M.A. Dronov, Yu.V. Ryabchikov, V.S. Neudachina, L.V. Yashina, L.G. Tomilova, D.R. Khokhlov. Infrared Spectroscopy of Semiconductor

- Structures Based on Alkyl-Substituted Lanthanide (III) Clam-Shell Mono-, Di-, and Di-Trisphthalocyanine Complexes. *Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics*, **6**, 1-6 (2011).
315. И.А. Белогорохов, Е.В. Тихонов, М.А. Дронов, Л.И. Белогорохова, Ю.В. Рябчиков, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов. Вибронные состояния в органических полупроводниках на основе безметалльного нафталоцианина, обнаружение гетероциклических соединений в гибкой диэлектрической матрице. *ФТП*, **46**, 103-108 (2012).
 316. V.I. Chernichkin, L.I. Ryabova, A.V. Nicorici, D.R. Khokhlov. Monopolar photoelectromagnetic effect in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ under terahertz laser radiation. *Semicond. Sci. Technol.*, **27**, 035011 (4 pp) (2012).
 317. A.V. Smirnov, A.M. Baryshev, P. de Bernardis, V.F. Vdovin, G.N. Gol'tsman, N.S. Kardashev, L.S. Kuz'min, V.P. Koshelets, A.N. Vystavkin, Yu.V. Lobanov, S.A. Ryabchun, M.I. Finkel, D.R. [Khokhlov](#). The current stage of development of the receiving complex of the Millimetron space observatory. *Radiophysics and Quantum Electronics*, **54**, 557-568 (2012).
 318. I.A. Belogorokhov, E.V. Tikhonov, M.A. Dronov, D.R. [Khokhlov](#). Dispersion dependences of the imaginary and real parts of the permittivity of erbium di- and triphthalocyanine-based organic semiconductors. *Optics and Spectroscopy*, **112**, 551-558 (2012).
 319. В.И. Кочнев, К.А. Дроздов, А.А. Добровольский, Р.Б. Васильев, А.В. Попело, М.Н. Румянцева, А.М. Гаськов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Эффективность переноса фотовозбужденных носителей заряда в структурах SnO_2-CdSe в зависимости от размера нанокристаллов $CdSe$. *XIX Уральская международная школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 20-25 февраля, 2012, тезисы докладов, с. 112-113.
 320. В.И. Черничкин, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Механизмы гашения задержанной фотопроводимости в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *XIX Уральская международная школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 20-25 февраля, 2012, тезисы докладов, с. 197-198.
 321. В.И. Черничкин, Л.И. Рябова, А.А. Добровольский, В.А. Касиян, З.М. Дашевский, С.Д. Ганичев, В.В. Бельков, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость пленок $PbTe(In)$ при возбуждении тепловым излучением и терагерцовыми лазерными импульсами. *XIX Уральская международная школа по физике полупроводников*, Екатеринбург – Новоуральск, 20-25 февраля, 2012, тезисы докладов, с. 249-250.
 322. Д.Р. Хохлов. Необычные примесные состояния в легированных сплавах на основе теллурида свинца. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, Санкт-Петербург-Зеленогорск, 24 - 27 февраля, 2012, тезисы докладов, с.23.
 323. В.И. Черничкин, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Гашение задержанной фотопроводимости в легированных сплавах на основе теллурида свинца. *XVI Международный симпозиум «Нанозифика и наноэлектроника»*, Нижний Новгород, 12-16 марта, 2012, труды симпозиума, т.2, с.421-422.
 324. L. Ryabova, V. Chernichkin, A. Dobrovolsky, V. Kasiyan, V. Bel'kov, S. Danilov, Z. Dashevsky, S. Ganichev, D. Khokhlov. $PbTe(In)$ films with variable microstructure for photodetection in IR and terahertz range. *Proc. SPIE*, **8439**, 84391H (2012).
 325. D. Dolzhenko, A. Nicorici, L. Ryabova, D. Khokhlov. A new type of sensitive semiconductor detectors of terahertz radiation. *Proc. SPIE*, **8431**, 843126 (2012).

326. D.E. Dolzhenko, L.I. Ryabova, A.V. Nicorici, D.R. Khokhlov. On a way to the passive terahertz imager. *7 China-Russia Joint Workshop on Advanced Semiconductor Materials and Devices*, Hangzhou, China, 23-27 April 2012, Abstracts, p. 13.
327. D.E. Dolzhenko, L.I. Ryabova, A.V. Nicorici, D.R. Khokhlov. Possibility for construction of a passive terahertz imager. *2 International Conference "Terahertz and Microwave Radiation: Generation, Detection and Applications"*, Moscow, Russia, 20-22 June 2012, Abstracts, p. 45.
328. V.I. Chernichkin, L.I. Ryabova, A.A. Dobrovolsky, V.A. Kasiyan, Z.M. Dashevsky, S.N. Danilov, V.V. Bel'kov, D.R. Khokhlov. Photoconductivity of PbTe(In) films excited by thermal radiation and terahertz laser pulses. *2 International Conference "Terahertz and Microwave Radiation: Generation, Detection and Applications"*, Moscow, Russia, 20-22 June 2012, Abstracts, p. 87.
329. D. Dolzhenko, A. Nicorici, L. Ryabova, D. Khokhlov. Sensitive semiconductor detectors of terahertz radiation for space-borne applications based on $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Proc. SPIE*, **8452**, 84520W (2012).
330. V. Kasiyan, Z. Dashevsky, C.M. Schwarz, M. Shatkhin, E. Flitsiyan, L. Chernyak, D. Khokhlov. Infrared detectors based on semiconductor p-n junctions of PbSe. *Journ. Appl. Phys.*, **112**, 086101 (5 pages) (2012).
331. V. Chernichkin, A. Dobrovolsky, V. Kasiyan, A. Nicorici, S. Danilov, L. Ryabova, Z. Dashevsky, D. Khokhlov. Observation of local electron states linked to the quasi-Fermi level. *Europhys. Lett.*, **100**, 17008 (3 pages) (2012).
332. E.V. Tikhonov, D.R. Khokhlov, Y.A. Uspenski, E.T. Kulatov, I.A. Belogorokhov. Electronic and Spin Structure of Metal Phthalocyanines. *Solid State Phenomena*, **190**, 141-144 (2012).
333. I.A. Belogorokhov, M.S. Kotova, E.V. Tikhonov, A.A. Volikhov, M.A. Dronov, Y.V. Ryabchikov, A.S. Vorontzov, M.N. Martyshov, P.A. Forsh, G.P. Boronina, V.E. Pushkarev, L.G. Tomilova, D.R. [Khokhlov](#). Transport and Spectroscopic Features of Composite Semiconductor Material Based on Poly[2-Methoxy-5-(2-Ethyl-Hexyloxy)-1,4-Phenylene-Vinylene]. *Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics*, **7**, 614-618 (2012).
334. А.И. Артамкин, А.А. Добровольский, А.А. Винокуров, В.П. Зломанов, С.Н. Данилов, В.В. Бельков, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость теллурида свинца, легированного ванадием, в терагерцовом спектральном диапазоне. *ФТП*, **47**, 293-296 (2013).
335. К.А. Дроздов, В.И. Кочнев, А.А. Добровольский, Р.Б. Васильев, А.В. Бабынина, М.Н. Румянцева, А.М. Гаськов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость композитных структур на основе пористого SnO_2 , сенсibilизированного нанокристаллами CdSe. *ФТП*, **47**, 360-363 (2013).
336. R.B. Vasiliev, A.V. Babynina, O.A. Maslova, M.N. Rumyantseva, L.I. Ryabova, A.A. Dobrovolsky, K.A. Drozdov, D.R. [Khokhlov](#), A.M. Abakumov, A.M. Gaskov. Photoconductivity of nanocrystalline SnO_2 sensitized with colloidal CdSe quantum dots. *Journal of Materials Chemistry C*, **1**, 1005-1010 (2013).
337. Д.Р. Хохлов. Высокочувствительные сенсоры терагерцового излучения. *Международная зимняя школа по физике полупроводников*, Санкт-Петербург-Зеленогорск, 01-04 марта, 2013, тезисы докладов, с.16-17.
338. Л.И. Рябова, А.В. Никорич, С.Н. Данилов, Д.Р. Хохлов. Терагерцовая фотопроводимость в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в магнитном поле. *XVII Международный симпозиум*

«Нанозифика и нанозлектроника», Нижний Новгород, 11-15 марта, 2013, труды симпозиума, т.2, с.635-636.

339. V. Chernichkin, L. Ryabova, A. Nicorici, S. Danilov, D. Khokhlov. Probing of local electron states in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ narrow-gap semiconductors. *2nd Russia-Japan-USA Symposium "Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies"*, Moscow, Russia, 3-6 June 2013, Abstracts, p.12.
340. D.R. Khokhlov. Sensitive detectors of terahertz radiation. *ICONO/LAT 2013*, Moscow, 18-22 June 2013, Abstracts, p.108.
341. L. Ryabova, A. Nicorici, S. Danilov, D. Khokhlov. Local electron states linked to the quasi-Fermi level in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ narrow-gap semiconductors. *55 Electronic Materials Conference*, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA, 26-28 June 2013, Abstracts, p.103.
342. Л.И. Рябова, А.В. Никорич, С.Н. Данилов, Д.Р. Хохлов. Влияние электрического тока и магнитного поля на терагерцовую фотопроводимость в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *Письма в ЖЭТФ*, **97**, 607-610 (2013).
343. Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Зондирование локальных электронных состояний в узкощелевых полупроводниках $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ с помощью лазерного терагерцового излучения. *Письма в ЖЭТФ*, **97**, 825-831 (2013).
344. Е.В. Тихонов, Ю.А. Успенский, Д.Р. Хохлов. Особенности электронной структуры и фотоэмиссионных спектров органических молекулярных полупроводников: молекулы металл – фталоцианинов и РТСДА. *Письма в ЖЭТФ*, **98**, 17-22 (2013).
345. V. Chernichkin, L. Ryabova, A. Nicorici, S. Danilov, D. Khokhlov. Probing of local electron states in $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ narrow-gap semiconductors using laser terahertz radiation. *38th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves*, Mainz, Germany, 1-6 September 2013, Abstracts, p.182.
346. D. Khokhlov, V. Chernichkin, A. Dobrovolsky, A. Nicorici, S. Danilov, L. Ryabova. Photosensitivity of lead telluride doped with mixed valence impurities in the terahertz spectral range. *38th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves*, Mainz, Germany, 1-6 September 2013, Abstracts, p.176.
347. В.И. Черничкин, Л.И. Рябова, А.В. Никорич, С.Н. Данилов, Д.Р. Хохлов. Влияние электрического и магнитного поля на терагерцовую фотопроводимость в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. *XI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013, тезисы докладов, с.42.
348. И.В. Крылов, К.А. Дроздов, А.А. Ирхина, Р.Б. Васильев, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Влияние примеси олова на оптические и фотоэлектрические свойства тонких наноструктурированных пленок In_2O_3 . *XI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013, тезисы докладов, с.324.
349. Л.И. Рябова, В.И. Черничкин, А.А. Добровольский, А.В. Никорич, С.Н. Данилов, Д.Р. Хохлов. Фотопроводимость теллурида свинца, легированного примесями с переменной валентностью, в терагерцовом диапазоне спектра. *XI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013, тезисы докладов, с.372.
350. Е.В. Тихонов, Ю.А. Успенский, Э.Т. Кулатов, Д.Р. Хохлов. Первопринципные расчеты электронной структуры молекулярных органических полупроводников. *XI Российская конференция по физике полупроводников*, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013, тезисы докладов, с.390.

351. K.A. Drozdov, V.I. Kochnev, A.A. Dobrovolsky, A.V. Popelo, M.N. Romyantseva, A.M. Gaskov, L.I. Ryabova, D.R. Khokhlov, R.B. Vasiliev. Photoconductivity of structures based on the SnO₂ porous matrix coupled with core-shell CdSe/CdS quantum dots. *Appl. Phys. Lett.* **103**, 133115 (2013) (4 pages).
352. J. Trajic, N. Romcevic, M. Romcevic, Z. Lazarevic, T.A. Kuznetsova, D.R. [Khokhlov](#). Plasmon - ionized impurity - phonon interaction in PbTe doped with Ni. *Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications*, **7**, 536-540 (2013).